INSTITUTO F

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Eletrônica de Potência



AULA LAB 03 SEMICONDUTORES DE POTÊNCIA: BJT, MOSFET E IGBT

Equipe	Data://
Nome:	
Nome:	

Atenção: A ordem dos itens da folha de dados é diferente daquela do roteiro de laboratório.

1 MOSFETS DE POTÊNCIA

Obtenha na internet a folha de dados do MOSFET IRF 540.

A seguir, verifique se o MOSFET está em boas condições, utilizando o multímetro.

Ajustando o resistor R_2 , verifique a operação do MOSFET na região de corte, ôhmica e saturação.

Levante a curva da corrente de dreno (I_D) em função da tensão entre gatilho e fonte (V_{GS}) do MOSFET, anotando os valores na Tabela 1.

Trace a curva da corrente de dreno em função da tensão entre gatilho e fonte conforme a Figura 1.

Tabela 1 – Valores da corrente de dreno e tensão entre gatilho e fonte.

Tuesta i Harris da Collega de Col			
V _{GS} [V]	V _{DS} [V]	Corrente de dreno [mA]	Resistência calculada entre dreno e fonte $[\Omega]$
0,0			
2,5			
2,6			
2,7			
2,8			
2,9			
3,0			
5,0			
10,0			
15,0			

Responda:

- 1) Qual a tensão de limiar do MOSFET?
- 2) O que pode ser concluído com relação à resistência do MOSFET entre dreno e fonte?
- 3) Determine a perda de condução do MOSFET.

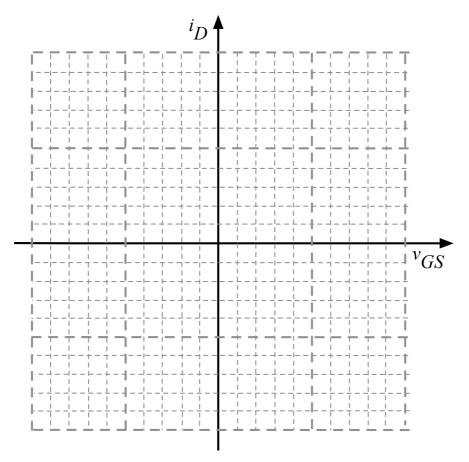


Figura 1 – Curva característica do MOSFET de potência.